

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成23年10月20日(2011.10.20)

【公表番号】特表2010-537867(P2010-537867A)

【公表日】平成22年12月9日(2010.12.9)

【年通号数】公開・登録公報2010-049

【出願番号】特願2010-524179(P2010-524179)

【国際特許分類】

B 29 C 33/40 (2006.01)

C 23 C 16/42 (2006.01)

B 29 C 33/64 (2006.01)

【F I】

B 29 C 33/40

C 23 C 16/42

B 29 C 33/64

【手続補正書】

【提出日】平成23年9月2日(2011.9.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

加工型を形成する方法であって、

チャンバ内の電極に基材を配置する工程であって、前記基材が少なくとも第1の構造化表面を有し、かつ前記基材が熱硬化性高分子材料を含むものである工程と、

前記チャンバに離型層形成ガスを導入する工程であって、前記離型層形成ガスが、シリコン含有ガスか又は約200以下の酸素対シリコンの原子比でシリコン含有ガスと酸素ガスとを含んでいる混合物を含むものである工程と、

前記チャンバ内に前記離型層形成ガスのプラズマを生成するために、電極に電力を提供する工程と、

前記離型層形成ガスから形成される離型層を、加工型を形成するために前記基材の前記第1の構造化表面の少なくとも一部に蒸着する工程と、を含む、方法。

【請求項2】

加工型を形成する方法であって、

架橋可能な材料を含んでいる第2世代の前駆体で主型をコーティングする工程と、

前記第2世代の前駆体から未処理の加工型を形成する工程であって、前記未処理の加工型が少なくとも第1の構造化表面を有し、かつ熱硬化性高分子材料を含むものである工程と、

チャンバ内の電極に前記未処理の加工型を配置する工程と、

前記チャンバに離型層形成ガスを導入する工程であって、前記離型層形成ガスが、シリコン含有ガスか又は約200以下の酸素対シリコンの原子比でシリコン含有ガスと酸素ガスとを含んでいる混合物を含むものである工程と、

前記チャンバ内に前記離型層形成ガスのプラズマを生成するために、前記電極に電力を提供する工程と、

前記離型層形成ガスから形成される離型層を、加工型を形成するために前記未処理の加工型の前記第1の構造化表面の少なくとも一部に蒸着する工程と、を含む、方法。

【請求項 3】

成形品を形成する方法であって、

未処理の加工型をチャンバ内の電極に配置する工程であって、前記未処理の加工型は少なくとも 1 つの第 1 の構造化表面を有し、かつ前記加工型は熱硬化性材料を含むものである工程と、

前記チャンバに離型層形成ガスを導入する工程であって、前記離型層形成ガスが、シリコン含有ガス又は約 200 以下の酸素対シリコンの原子比でシリコン含有ガスと酸素ガスとを含んでいる混合物を含むものである工程と、

前記チャンバ内に前記離型層形成ガスのプラズマを生成するために、電極に電力を供給する工程と、

前記離型層形成ガスから形成される離型層を、加工型を形成するために前記未処理の加工型の前記第 1 の構造化表面の少なくとも一部に蒸着する工程と、

前記加工型の前記第 1 の構造化表面のインバースである成形品を形成するために、第 3 世代の前駆体を前記加工型の前記第 1 の表面の少なくとも一部に接触させる工程と、を含む、方法。